

序説

お客様が受け取ったAVR32DB28/32/48デバイスはこの文書で記述される異常を除き、現在のデバイスのデータシート(www.microchip.com/DS40002301)に対して機能的に一致します。この文書で記述される障害はAVR32DB28/32/48デバイスの将来の改訂で処置されるかもしれません。

注: ・この文書は現在と過去のシリコンの全ての版からの全てのシリコン障害問題を要約します。

- ・特定デバイスに対するデバイス識別と改訂のIDのより多くの詳細な情報については、デバイスの現在のデータシート(www.microchip.com/DS40002301)でデバイス/改訂ID部分を参照するか、または手助けのために最寄りのMicrochip営業所にお問い合わせください。

本書は一般の方々の便宜のため有志により作成されたもので、Microchip社とは無関係であることを御承知ください。しおりの[はじめに]での内容にご注意ください。

1. シリコン問題要約

凡例

- 障害は適用されません。
- × 障害が適用されます。

周辺機能	簡単な説明	シリコン改訂に対する有効性		
		改訂	A1(注)	B0
デバイス	2.2.1. VDD低下時に起こるかもしれない消費電流増加	×	-	
	2.2.2. 特定アドレス空間への連続書き込みの場合に失われる書き込み操作	×	×	
CLKCTRL	2.3.1. 外部クリスタルでXOSCHF使用時に動かないPLL	×	-	
DAC	2.4.1. DAC出力緩衝部の生涯変動	×	-	
NVMCTRL	2.5.1. 書き込み保護された部分を消去し得るフラッシュ複数ページ消去	×	×	
	2.5.2. 書き込み保護を遵守しないNVM_EEPROM_ERASE指令	×	×	
TCA	2.6.1. NORMALとFRQの動作で計数方向をリセットする再始動	×	-	
TCB	2.7.1. 8ビットPWM動作で16ビットレジスタとして機能するCCMPとCNTのレジスタ	×	-	
TCD	2.8.1. TCD計数器前置分周器使用時に動かない非同期入力事象	×	-	
	2.8.2. 代替ピン機能に対して全WO _x を制御するCMPAEN	×	-	
	2.8.3. 比較A値が‘0’または2傾斜動作使用時に動かないTCD停止とソフトウェア再開待ち	×	×	
TWI	2.9.1. 機能しない解消	×	×	
USART	2.10.1. 活動動作で意図せず起動され得るフレーム開始検出	×	-	
	2.10.2. 矛盾する同期領域検出後に機能しない受信部	×	×	

注: この版がシリコンの初版です。

2. シリコン障害問題

2.1. 障害詳細

- 障害は適用されません。
- × 障害が適用されます。

2.2. デバイス

2.2.1. VDD低下時に起こるかもしれない消費電流増加

デバイスはVDDが2.1V未満に低下して1.9~2.1Vの範囲を保たれる場合に概ね1.5mAの消費電流増加を経験するかもしれません。これは元々VDDがより高い水準でその後と言及した電圧範囲に低下する場合にだけ起きます。

対策/対処:

VDDが影響を及ぼされる電圧範囲に向かって落ちる場合の実行からデバイスを守るため、BOD起動基準を2.2Vに設定することによってVDDが常に2.1V越えを保つことを保証してください。1.9~2.1Vの電圧範囲での動作が必要とされなら、VDDが2.1Vを超えて上昇してその後再び低下しないことを確実にしてください。与えられた電圧基準が絶対値ではなく、代表値であることに注意してください。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	A1	B0																			
影響	×	-																			

2.2.2. 特定アドレス空間への連続書き込みの場合に失われる書き込み操作

アドレス≧64へのST/STD/STS命令に続く、アドレス<64へのST/STD命令または休止制御器の制御A(SLPCTRL.CTRLA)レジスタへの書き込みのどちらでも最後の書き込みを失います。

対策/対処:

書き込み操作の消失を避けるため、アドレス空間に応じて以下の対策の1つを使ってください。

- ・アドレス<64への書き込み前にNOP命令を挿入するか、またはST/STDの代わりにOUT命令を使ってください。
- ・SLPCTRL.CTRLAレジスタへの書き込み前にNOP命令を挿入してください。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	A1	B0																			
影響	×	×																			

2.3. CLKCTRL – クロック制御器

2.3.1. 外部クリスタルでXOSC HF使用時に動かないPLL

PLLが外部供給元から動くよう(PLL制御A(CLKCTRL.PLLCTRLA)のPLL用供給元選択(SOURCE)が'1')に構成設定されると、PLLはXOSC HFが外部クロックを使うよう(外部高周波数発振器(CLKCTRL.XOSCHFCTRLA)の供給元選択(SELHF)が'1')に構成設定される場合にだけ動きます。外部クリスタルでは動きません。

対策/対処:

ありません。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	A1	B0																			
影響	×	-																			

2.4. DAC – D/A変換器

2.4.1. DAC出力緩衝部の生涯変動

DAC出力緩衝部の変位(オフセット)はデバイスがDAC出力緩衝部禁止で給電される場合、生涯に渡って変動し得ます。

対策/対処:

継続的にDAC出力緩衝部許可(制御A(DACn.CTRLA)の出力緩衝部許可(OUTEN)が'1')を保つか、またはDAC出力を測定することによって補償してください。

影響を及ぼされるシリコン改訂

2.10. USART – 万能同期/非同期送受信器

2.10.1. 活動動作で意図せず許可され得るフレーム開始検出

フレーム開始検出機能はデータ受信でスタンバイ休止動作から起こすためにUSARTを許可します。

フレーム開始検出器はデバイスが活動動作で制御B(USARTn.CTRLB)レジスタのフレーム開始検出許可(SFDEN)ビットが設定(1)される時に意図せず起動され得ます。新しいデータを受信している間に受信データ(RXDATA)レジスタが読まれる場合、状態(USARTn.STATUS)レジスタの受信完了割り込み要求フラグ(RXCIF)が解除(0)されます。これはフレーム開始検出器を起動し、次の下降端を誤って開始ビットとして検出します。フレーム開始検出器が開始条件を検出すると、フレーム受信が再始動され、不正な受信データに帰着します。活動動作時にUSART受信開始割り込み要求フラグ(RXSIF)は常に'0'であることに注意してください。割り込みは起動されません。

対策/対処:

デバイスが活動動作の時はUSART制御B(USARTn.CTRLB)レジスタのフレーム開始検出許可(SFDEN)ビットに'0'を書くことによってフレーム開始検出器を禁止してください。スタンバイ休止動作へ遷移する前にこのビットに'1'を書くことによって再びそれを許可してください。この対策はフレーム開始検出を再許可する時に新しくやって来るフレームを防ぐ規約に依存します。新しいフレームが既にやって来ている間でのフレーム開始検出再許可は不正な受信データに帰着します。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	A1	B0																																					
影響	X	-																																					

2.10.2. 矛盾する同期領域検出後に機能しない受信部

USART受信部は状態(USARTn.STATUS)レジスタで矛盾同期領域割り込み要求フラグ(ISFIF)が設定(1)されると、機能しなくなります。ISFIF割り込み要求フラグは制御B(USARTn.CTRLB)レジスタの受信動作(RXMODE)ビット領域が標準自動ポーレート動作(GENAUTO)またはLIN制限自動ポーレート動作(LINAUTO)に構成設定され、受信した同期フレームがデータシートで記述されたような条件に準拠していない時に設定(1)されます。このフラグの解除'0'はUSART受信部を再許可しません。

対策/対処:

ISFIF割り込み要求フラグが設定(1)された時は制御B(USARTn.CTRLB)レジスタの受信許可(RXEN)ビットへ最初に'0'その後'1'を書くことによってUSART受信部を禁止して再許可してください。

影響を及ぼされるシリコン改訂

改訂	A1	B0																																						
影響	X	X																																						

3. データシート説明

デバイスのデータシート(www.microchip.com/DS40002301)の最新版に対して以降の誤植修正と説明に注意されるべきです。

注: 修正は太字で示されます。可能な場合、明確にするため、元の太字の文字書式は削除されています。

3.1. デバイス

3.1.1. 特徴

特徴一覧のメモリ箇条書きでのフラッシュ耐久性仕様を変更するように明確化が行われました。

- メモリ
 - 実装自己書き換え可能な32Kバイト(16K語)のフラッシュメモリ
 - 512バイトのEEPROM
 - 4KバイトのSRAM
 - チップ消去間もデータを保持してデバイスが施錠中でも書くことができる不揮発性メモリ内の32バイトの使用者列
 - 書き込み/消去耐久性
 - フラッシュメモリ 1,000回
 - EEPROM 100,000回
 - データ保持力: 55°Cで40年

3.1.2. FUSE – 構成設定と使用者のヒューズ – SYSCFG0

システム構成設定0(SYSCFG0、8.8.2.4.項)ヒューズのチップ消去中EEPROM保存(EESAVE)ヒューズ説明の計画化が行われました。

● ビット0 – EESAVE: チップ消去中EEPROM保存 (EEPROM Saved during chip erase)

このビットはチップ消去中にEEPROMが消去されるか保存されるかを制御します。

値	0	1
名称	DISABLE	ENABLE
説明	チップ消去中にEEPROMが消去されます。	デバイスが施錠されているか否かに関わらず、チップ消去中にEEPROMは保存されます。

3.2. SPI – 直列周辺インターフェース

3.2.1. SPI – 直列周辺インターフェース

「動作」-「従装置動作」項に対して明確化が行われました。最後の文が削除されます。

28.3.2.2. 従装置動作

従装置動作で、SPI周辺機能は主装置からSPIクロックと従装置選択を受け取ります。従装置動作は3つの動作形態、1つの標準動作と緩衝動作用の2つの構成設定を支援します。従装置動作で、制御論理回路はSCKピンでやって来る信号を採取します。このクロック信号の正しい採取を保証するため、最小のLowとHighの期間は各々2周辺機能クロック周期よりも長くなければなりません。

3.2.2. SPI – 直列周辺インターフェース

「動作」-「従装置動作」-「緩衝動作」項に対して明確化が行われました。

28.3.2.2.2. 緩衝動作

データ衝突を避けるため、SPI周辺機能は制御B(SPIIn.CTRLB)レジスタの緩衝動作許可(BUFEN)ビットに'1'を書くことによって緩衝動作に構成設定することができます。

この動作では2つの受信緩衝部と1つの送信緩衝部を持ちます。双方は独立した割り込み要求フラグの送信完了と受信完了を持ちます。図28-1.は追加の緩衝部を示します。

緩衝動作が許可される時に2つの異なる方法で動くことができます。制御B(SPIIn.CTRLB)レジスタの緩衝動作受信待機(BUFWR)ビットは緩衝動作がどう動くかを制御します。タイミング構成図を含みそれらがどう動くかの詳細が下で記述されます。

注: 緩衝動作で従装置として動作し、SPIクロックが最大周波数に近いと、従装置は連続転送間の最初の採取端に対して時間内にデータを準備できないかもしれません。詳細については「電気的特性」の「SPI」項を参照してください。

3.3. AC – アナログ比較器

3.3.1. アナログ比較器割り込み制御

AC割り込み制御(ACn.INTCTRL、32.5.5.項)レジスタの割り込み動作(INTMODE)ビット領域の明確化が行われました。

表32-4. 単独比較器での割り込み生成

値	0 0	0 1	1 0	1 1
名称	BOTHEDGE	-	NEGEDGE	POSEDGE
説明	正と負の入力交差	(予約)	正入力が増入力未満へ	正入力が増入力越えへ

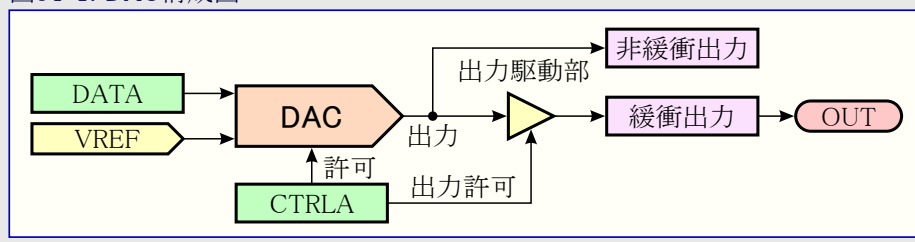
3.4. DAC - D/A変換器

3.4.1. DAC出力

次のようにDAC周辺機能の構成図と「DAC出力」副項の明確化が行われました。

1. 構成図は出力信号配線(緩衝/非緩衝)に対する明確化で格子され、元の構成図を置き換えます。
2. 34.3.2.3.(内部周辺機能用供給元としてのDAC)と34.3.2.4.(ピンでのDAC出力)の部分は「34.3.2.3 DAC出力」項によって置き換えられます。

図34-1. DAC構成図



34.3.2.3. DAC出力

DACはピンへの出力として、下表の周辺機能への入力として使うことができます。

DAC出力	周辺機能入力	注記
非緩衝	A/D変換器(ADC)	本周辺機能は非緩衝DAC出力に接続されます。「34.3.2.3.1. 内部周辺機能用供給元としての非緩衝出力」項をご覧ください。
緩衝	アナログ信号調整(OPAMP)	この周辺機能はDAC出力ピンに接続されます。「34.3.2.3.2. 緩衝出力」項をご覧ください。

34.3.2.3.1. 内部周辺機能用供給元としての非緩衝出力

DACの非緩衝アナログ出力は制御A(DACn.CTRLA)レジスタのDAC許可(ENABLE)ビットが'1'を書かれる時に他の周辺機能へ内部的に接続されます。DAC非緩衝アナログ出力だけが使われる時は、DACn.CTRLAの出力緩衝部許可(OUTEN)ビットを'0'にすることができ、ピンを他の周辺機能によって使われるように自由にします。

34.3.2.3.2. 緩衝出力

DACの緩衝アナログ出力は制御A(DACn.CTRLA)レジスタの出力緩衝部許可(OUTEN)ビットに'1'を書くことによって許可することができます。DACに使われるピンはPORT周辺機能で禁止された入力を持たなければなりません。DAC出力緩衝部の駆動能力については「電気的特性」章を参照してください。

3.5. 電気的特性

3.5.1. 入出力ピン特性

「入出力ピン特性」表にいくつかの明確化が行われました。1つの脚注が削除されたことに注意してください。

表39-6. 入出力ピン特性 (注1)

シンボル	説明	最小	代表 (+)	最大	単位	条件	
Low入力電圧							
VIL	入出力ポート	・シュミットトリガ緩衝部	-	-	0.2VDD	V	PINnCTRL.INLVL='0'
		・TTL基準	-	-	0.8		PINnCTRL.INLVL='1', VDD>2.7V
	TWIポート	・I ² C基準	-	-	0.3VDD		CTRLA.INPUTLVL='0'
		・SMBus 3.0基準	-	-	0.8		CTRLA.INPUTLVL='1'
	RESETピン	-	-	0.2VDD			
High入力電圧							
VIH	入出力ポート	・シュミットトリガ緩衝部	0.8VDD	-	-	V	PINnCTRL.INLVL='0'
		・TTL基準	1.6	-	-		PINnCTRL.INLVL='1', VDD>2.7V
	TWIポート	・I ² C基準	0.7VDD	-	-		CTRLA.INPUTLVL='0'
		・SMBus 3.0基準	1.35	-	-		CTRLA.INPUTLVL='1'
	RESETピン	0.8VDD	-	-			
入力漏れ電流 (注2)							
IIL	入出力ポート (注3)	-	<5	-	nA	GND ≤ VPIN ≤ VDD、 高インピーダンスピン	TA=85°C
		-	<5	-			TA=125°C
	RESETピン (注4)	-	±50	-		TA=85°C	
プルアップ電流							
IPUR	-	-	140	-	μA	VDD=3.0V、VPIN=GND	
Low出力電圧							
VOL	標準入出力ポート	-	-	0.6	V	VDD=3.0V、IOL=10mA	
High出力電圧							
VOH	標準入出力ポート	VDD-0.7	-	-	V	VDD=3.0V、IOH=6mA	
入出力ピン スルーレート							
	上昇スルーレート	-	22	-	ns	PINnCTRL.SRL='0'	
		-	45	-		PINnCTRL.SRL='1'	
	下降スルーレート	-	16	-		PINnCTRL.SRL='0'	
		-	30	-		PINnCTRL.SRL='1'	
ピン容量							
CIO	演算増幅器出力	-	9	-	pF		
	VREFピン	-	7	-			
	XTALピン	-	4	-			
	その他のピン	-	4	-			

†: “代表”列のデータは別の定めがない限り、TA=25°CとVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

注1: これらの数値はそれらがVDDまたはVDDIO2のどちらの電力区域に接続されるかに関わらず、全ての入出力ポートに対して有効です。

注2: 負(-)の電流はピンによって吐き出される電流です。

注3: 入出力ポートの漏れ電流はそのピンが許可されたアナログ周辺機能の入力として使われる時にも有効です。

注4: RESETピンの漏れ電流は印加される電圧水準に大きく依存します。指定した基準は標準的な動作条件を表します。違う入力電圧ではより高い漏れ電流が測定されるかもしれません。

3.5.2. メモリプログラミング仕様

「メモリプログラミング仕様」表でフラッシュメモリセル寿命を変更するように明確化が行われました。

表39-8. メモリプログラミング仕様 (注1)

シンボル	説明	最小	代表	最大	単位	条件
データ用EEPROMメモリ仕様						
ED	データEEPROMバイト耐久性	100000	-	-	消去/書き回数	$-40^{\circ}\text{C} \leq \text{TA} \leq +85^{\circ}\text{C}$
tD_RET	保持特性	-	40	-	年	他の仕様違反なしの条件で
ND_REF	刷新前の総消去/書き回数	1000000	4000000	-	消去/書き回数	$-40^{\circ}\text{C} \leq \text{TA} \leq +85^{\circ}\text{C}$
tD_CE	EEPROM全体消去時間	-	10	-	ms	
VD_RW	読みまたは消去/書き操作VDD	VDDMIN	-	VDDMAX	V	
tD_BEW	バイト消去/書き込み時	-	11	-	ms	
プログラム用フラッシュメモリ仕様						
EP	フラッシュメモリセル耐久性	1000	-	-	消去/書き回数	$-40^{\circ}\text{C} \leq \text{TA} \leq +85^{\circ}\text{C}$
tP_RET	保持特性	-	40	-	年	他の仕様違反なしの条件で
VP_RD	読み操作VDD	VDDMIN	-	VDDMAX	V	
VP_REW	消去/書き操作VDD	VDD (注2)	-	VDDMAX		
tP_PE	ページ消去	-	10	-	ms	
tP_CE	チップ消去	-	-	-		
tP_WRD	バイト/語書き	-	70	-	μs	

注1: これらの要素は検査されていませんが、設計によって保証されます。

注2: チップ消去の間、BODLEVEL0で構成設定された低電圧検出器(BOD)がONを強制されます。VDD供給電圧がBODLEVEL0に対するVBOD未満の場合、消去の試みは失敗するでしょう。

3.5.3. SPI

「主装置動作でのタイミング仕様」と「従装置動作でのタイミング仕様」の表でいくつかの明確化が行われました。いくつかの行が削除されたことに注意してください。

表39-20. SPI - 主装置動作でのタイミング仕様

シンボル	説明	最小	代表 (+)	最大	単位	条件
$f_{\text{SCK}} (*)$	SCKクロック周波数	-	-	$f_{\text{CLK_PER}}/2$	MHz	
T _{SCK} (*)	SCK周期	$2 \times \text{TCLK_PER}$	-	-		
t _{SCKW}	SCK High/Low幅	-	$0.5 \times \text{T}_{\text{SCK}}$	-		
t _{MIS}	SCKに対するMISO準備時間	-	TCLK_PER	-	ns	
t _{MIH}	SCK後MISO保持時間	-	0	-		
t _{MOS}	SCKに対するMOSI準備時間	-	$0.5 \times \text{T}_{\text{SCK}}$	-		
t _{MOH}	SCK後MOSI保持時間	-	$0.5 \times \text{T}_{\text{SCK}}$	-		

†: “代表”列のデータは別の定めがない限り、TA=25°CとVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

*: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

表39-21. SPI - 従装置でのタイミング仕様

シンボル	説明	最小	代表 (+)	最大	単位	条件
$f_{\text{SSCK}} (*)$	従装置SCKクロック周波数	-	-	$f_{\text{CLK_PER}}/6$	MHz	
T _{SSCK} (*)	従装置SCK周期	$6 \times \text{TCLK_PER}$	-	-		
t _{SSCKW} (*)	SCK High/Low幅	$3 \times \text{TCLK_PER}$	-	-		
t _{SSIS} (*)	SCKに対するMOSI準備時間	0	-	-		
t _{SSIH} (*)	SCK後MOSI保持時間	$3 \times \text{TCLK_PER}$	-	-		
t _{SSSS} (*)	SCKに対するSS準備時間	TCLK_PER	-	-	ns	
t _{SSSH} (*)	SCK後SS保持時間	TCLK_PER	-	-		
t _{SOS}	SCK後のMISO有効時間	-	t _{SR}	-		$f_{\text{SSCK}} \geq f_{\text{CLK_PER}}/6$
		-	-	-		$f_{\text{SSCK}} < f_{\text{CLK_PER}}/6$
t _{SOSS}	SS Low後MISO準備時間	-	t _{SR}	-		
t _{SOSH}	SS Low後MISO保持時間	-	t _{SR}	-		

†: “代表”列のデータは別の定めがない限り、TA=25°CとVDD=3.0Vです。これらの要素は設計指針用だけで検査されません。

*: これらの要素は特性付けされますが、製造で検査されません。

4. 文書改訂履歴

注: この文書改訂はシリコン改訂と無関係です。

4.1. 改訂履歴

文書改訂	日付	注釈
A	2021年2月	初回文書公開
B	2022年3月	<ul style="list-style-type: none"> • 文書: 全般的な編集上の更新 • 障害追加: <ul style="list-style-type: none"> - DAC : 2.4.1. DAC出力緩衝部の生涯変動 - NVMCTRL : 2.5.1. 書き込み保護された部分を消去し得るフラッシュ複数ページ消去 - TCD : 2.8.3. 比較A値が‘0’または2傾斜動作使用時に動かないTCD停止とソフトウェア再開待ち - TWI : 2.9.1. 機能しない解消 • データシート説明追加: <ul style="list-style-type: none"> - デバイス : • 3.1.1. 特徴 <li style="padding-left: 40px;">• 3.1.2. FUSE - 構成設定と使用者ヒューズ - SYSCFG0 - AC : • 3.3.1. アナログ比較器割り込み制御 - DAC : • 3.4.1. DAC出力 - 電気的特性 : • 3.5.2. 電気的特性 - メモリプログラミング仕様
C	2024年2月	<ul style="list-style-type: none"> • 文書: 全般的な編集上の更新 • シリコン改訂追加: B0 • 障害追加: <ul style="list-style-type: none"> - デバイス : 2.2.2. 特定アドレス空間への連続書き込みの場合に失われる書き込み操作 - NVMCTRL : 2.5.2. 書き込み保護を遵守しないNVM_EEPROM_ERASE指令 - USART : 2.10.2. 矛盾する同期領域検出後に機能しない受信部 • データシート説明追加: <ul style="list-style-type: none"> - SPI : • 3.2.1. SPI - 直列周辺インターフェース <li style="padding-left: 40px;">• 3.2.2. SPI - 直列周辺インターフェース - 電気的特性 : • 3.5.1. 入出力ピン特性 <li style="padding-left: 40px;">• 3.5.3. SPI

Microchip情報

Microchipウェブ サイト

Microchipはwww.microchip.com/で当社のウェブ サイト経由でのオンライン支援を提供します。このウェブ サイトはお客様がファイルや情報を容易に利用可能にするのに使われます。利用可能な情報のいくつかは以下を含みます。

- **製品支援** – データシートと障害情報、応用記述と試供プログラム、設計資源、使用者の手引きとハードウェア支援資料、最新ソフトウェア配布と保管されたソフトウェア
- **一般的な技術支援** – 良くある質問(FAQ)、技術支援要求、オンライン検討グループ、Microchip設計協力課程会員一覧
- **Microchipの事業** – 製品選択器と注文の手引き、最新Microchip報道発表、セミナーとイベントの一覧、Microchip営業所の一覧、代理店と代表する工場

製品変更通知サービス

Microchipの製品変更通知サービスはMicrochip製品を最新に保つのに役立ちます。加入者は指定した製品系統や興味のある開発ツールに関連する変更、更新、改訂、障害情報がある場合に必ず電子メール通知を受け取ります。

登録するにはwww.microchip.com/pcnへ行って登録指示に従ってください。

お客様支援

Microchip製品の使用者は以下のいくつかのチャネルを通して支援を受け取ることができます。

- 代理店または販売会社
- 最寄りの営業所
- 組み込み解決技術者(ESE:Embedded Solutions Engineer)
- 技術支援

お客様は支援に関してこれらの代理店、販売会社、またはESEに連絡を取るべきです。最寄りの営業所もお客様の手助けに利用できます。営業所と位置の一覧はこの資料の後ろに含まれます。

技術支援はwww.microchip.com/supportでのウェブ サイトを通して利用できます。

Microchipデバイス コード保護機能

Microchip製品での以下のコード保護機能の詳細に注意してください。

- Microchip製品はそれら特定のMicrochipデータシートに含まれる仕様に合致します。
- Microchipは動作仕様内で意図した方法と通常条件下で使われる時に、その製品系統が安全であると考えます。
- Microchipはその知的所有権を尊重し、積極的に保護します。Microchip製品のコード保護機能を侵害する試みは固く禁じられ、デジタル ミレニアム著作権法に違反するかもしれません。
- Microchipや他のどの半導体製造業者もそのコードの安全を保証することはできません。コード保護は製品が”破ることができない”ことを当社が保証すると言うことを意味しません。コード保護は常に進化しています。Microchipは当社製品のコード保護機能を継続的に改善することを約束します。

法的通知

この刊行物と契約での情報は設計、試験、応用とのMicrochip製品の統合を含め、Microchip製品でだけ使えます。他の何れの方法でのこの情報の使用はこれらの条件に違反します。デバイス応用などに関する情報は皆さまの便宜のためにだけ提供され、更新によって取り換えられるかもしれません。皆さまの応用が皆さまの仕様に合致するのを保証するのは皆さまの責任です。追加支援については最寄りのMicrochip営業所にお問い合わせ頂くか、www.microchip.com/en-us/support/design-help/client-support-servicesで追加支援を得てください。

この情報はMicrochipによって「現状そのまま」で提供されます。Microchipは非侵害、商品性、特定目的に対する適合性の何れの黙示的保証やその条件、品質、性能に関する保証を含め、明示的にも黙示的にもその情報に関連して書面または表記された書面または黙示の如何なる表明や保証もしません。

如何なる場合においても、Microchipは情報またはその使用に関連するあらゆる種類の間接的、特別的、懲罰的、偶発的または結果的な損失、損害、費用または経費に対して責任を負わないものとします。法律で認められている最大限の範囲で、情報またはその使用に関連する全ての請求に対するMicrochipの全責任は、もしあれば、情報のためにMicrochipへ直接支払った料金を超えないものとします。生命維持や安全応用でのMicrochipデバイスの使用は完全に購入者の危険性で、購入者はそのような使用に起因する全ての損害、請求、訴訟、費用からMicrochipを擁護し、補償し、免責することに同意します。他に言及されない限り、Microchipのどの知的財産権下でも暗黙的または違う方法で許認可は譲渡されません。

商標

Microchipの名前とロゴ、Microchip、Adaptec、AVR、AVR、AVR Freaks、BesTime、BitCloud、CryptoMemory、CryptoRF、dsPIC、flexPWR、HELDO、IGLOO、JukeBlox、KeeLoq、Kleer、LANCheck、LinkMD、maxStylus、maxTouch、MediaLB、megaAVR、Microsemi、Microsemi、MOST、MOST、MPLAB、OptoLyzer、PIC、picoPower、PICSTART、PIC32、PolarFire、Prochip Designer、QTouch、SAM-BA、SenGenuity、SpyNIC、SST、SST、Super Flash、Symmetricom、SyncServer、Tachyon、TimeSource、tinyAVR、UNI/O、Vectron、XMEGAは米国と他の国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの登録商標です。

AgileSwitch、ClockWorks、The Embedded Control Solutions Company、EtherSynch、Flashtec、Hyper Speed Control、HyperLight Load、IntelliMOS、Libero、motorBench、mTouch、Powermite 3、Precision Edge、ProASIC、ProASIC Plus、ProASIC Plus、Quiet-Wire、SmartFusion、SyncWorld、TimeCesium、TimeHub、TimePictra、TimeProvider、ZLは米国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの登録商標です。

Adjacent Key Suppression、AKS、Analog-for-the-Digital Age、Any Capacitor、AnyIn、AnyOut、Augmented Switching、BlueSky、BodyCom、Clockstudio、CodeGuard、CryptoAuthentication、CryptoAutomotive、CryptoCompanion、CryptoController、dsPICDEM、dsPICDEM.net、Dynamic Average Matching、DAM、ECAN、Espresso T1S、EtherGREEN、EyeOpen、GridTime、IdealBridge、IGaT、In-Circuit Serial Programming、ICSP、INICnet、Intelligent Paralleling、IntelliMOS、Inter-Chip Connectivity、JitterBlocker、Knob-on-Display、MarginLink、maxCrypto、maxView、memBrain、Mindi、MiWi、MPASM、MPF、MPLAB Certified、MPLIB、MPLINK、mSiC、MultiTRAK、NetDetach、Omniscient Code Generation、PICDEM、PICDEM.net、PICKit、PICtail、Power MOS IV、Power MOS 7、PowerSmart、PureSilicon、QMatrix、REAL ICE、Ripple Blocker、RTAX、RTG4、SAM-ICE、Serial Quad I/O、simpleMAP、SimpliPHY、SmartBuffer、SmartHLS、SMART-I.S.、storClad、SQI、SuperSwitcher、SuperSwitcher II、Switchtec、SynchroPHY、Total Endurance、Trusted Time、TSHARC、Turing、USBCheck、VariSense、Vector Blox、VeriPHY、ViewSpan、WiperLock、XpressConnect、ZENAは米国と他の国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの商標です。

SQTPは米国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの役務標章です。

Adaptec、Frequency on Demand、Silicon Storage Technology、Symmcomは他の国に於けるMicrochip Technology Inc.の登録商標です。

GestICは他の国に於けるMicrochip Technology Inc.の子会社であるMicrochip Technology Germany II GmbH & Co. KGの登録商標です。

ここで言及した以外の全ての商標はそれら各々の会社の所有物です。

© 2024年、Microchip Technology Incorporatedとその子会社、不許複製

品質管理システム

Microchipの品質管理システムに関する情報についてはwww.microchip.com/qualityを訪ねてください。

日本語© HERO 2024.

本データシートはMicrochipのAVR32DB28/32/48障害とデータシート説明の英語版資料(DS80000938C-2024年2月)の翻訳日本語版です。日本語では不自然となる重複する形容表現は省略されている場合があります。日本語では難解となる表現は大幅に意識されている部分もあります。必要に応じて一部加筆されています。頁割の変更により、原本より頁数が少なくなっています。

汎用入出力ポートの出力データレジスタとピン入力は、対応関係からの理解の容易さから出力レジスタと入力レジスタで統一表現されています。一部の用語がより適切と思われる名称に変更されています。必要と思われる部分には()内に英語表記や略称などを残す形で表記しています。

青字の部分はリンクとなっています。一般的に赤字の0,1は論理0,1を表します。その他の赤字は重要な部分を表します。

世界的な販売とサービス

米国	亜細亜/太平洋	亜細亜/太平洋	欧州
本社 2355 West Chandler Blvd. Chandler, AZ 85224-6199 Tel: 480-792-7200 Fax: 480-792-7277 技術支援: www.microchip.com/support ウェブアドレス: www.microchip.com	オーストラリア - シドニー Tel: 61-2-9868-6733 中国 - 北京 Tel: 86-10-8569-7000 中国 - 成都 Tel: 86-28-8665-5511 中国 - 重慶 Tel: 86-23-8980-9588 中国 - 東莞 Tel: 86-769-8702-9880 中国 - 広州 Tel: 86-20-8755-8029 中国 - 杭州 Tel: 86-571-8792-8115 中国 - 香港特别行政区 Tel: 852-2943-5100 中国 - 南京 Tel: 86-25-8473-2460 中国 - 青島 Tel: 86-532-8502-7355 中国 - 上海 Tel: 86-21-3326-8000 中国 - 瀋陽 Tel: 86-24-2334-2829 中国 - 深圳 Tel: 86-755-8864-2200 中国 - 蘇州 Tel: 86-186-6233-1526 中国 - 武漢 Tel: 86-27-5980-5300 中国 - 西安 Tel: 86-29-8833-7252 中国 - 廈門 Tel: 86-592-2388138 中国 - 珠海 Tel: 86-756-3210040	インド - ハンガロール Tel: 91-80-3090-4444 インド - ニューデリー Tel: 91-11-4160-8631 インド - プネー Tel: 91-20-4121-0141 日本 - 大阪 Tel: 81-6-6152-7160 日本 - 東京 Tel: 81-3-6880-3770 韓国 - 大邱 Tel: 82-53-744-4301 韓国 - ソウル Tel: 82-2-554-7200 マレーシア - クアラルンプール Tel: 60-3-7651-7906 マレーシア - ペナン Tel: 60-4-227-8870 フィリピン - マニラ Tel: 63-2-634-9065 シンガポール Tel: 65-6334-8870 台湾 - 新竹 Tel: 886-3-577-8366 台湾 - 高雄 Tel: 886-7-213-7830 台湾 - 台北 Tel: 886-2-2508-8600 タイ - バンコク Tel: 66-2-694-1351 ベトナム - ホーチミン Tel: 84-28-5448-2100	オーストラリア - ウェルズ Tel: 43-7242-2244-39 Fax: 43-7242-2244-393 デンマーク - コペンハーゲン Tel: 45-4485-5910 Fax: 45-4485-2829 フィンランド - エスポー Tel: 358-9-4520-820 フランス - パリ Tel: 33-1-69-53-63-20 Fax: 33-1-69-30-90-79 ドイツ - ガルピング Tel: 49-8931-9700 ドイツ - ハーン Tel: 49-2129-3766400 ドイツ - ハイムブロン Tel: 49-7131-72400 ドイツ - カールスルーエ Tel: 49-721-625370 ドイツ - ミュンヘン Tel: 49-89-627-144-0 Fax: 49-89-627-144-44 ドイツ - ローゼンハイム Tel: 49-8031-354-560 イスラエル - ラーナナ Tel: 972-9-744-7705 イタリア - ミラノ Tel: 39-0331-742611 Fax: 39-0331-466781 イタリア - ハットバ Tel: 39-049-7625286 オランダ - テルネン Tel: 31-416-690399 Fax: 31-416-690340 ノルウェー - トロンハイム Tel: 47-72884388 ポーランド - ワルシャワ Tel: 48-22-3325737 ルーマニア - ブカレスト Tel: 40-21-407-87-50 スペイン - マドリード Tel: 34-91-708-08-90 Fax: 34-91-708-08-91 スウェーデン - イェーテボリ Tel: 46-31-704-60-40 スウェーデン - ストックホルム Tel: 46-8-5090-4654 イギリス - ウォーキングム Tel: 44-118-921-5800 Fax: 44-118-921-5820
アランタ Duluth, GA Tel: 678-957-9614 Fax: 678-957-1455 オースチン TX Tel: 512-257-3370 ホストン Westborough, MA Tel: 774-760-0087 Fax: 774-760-0088 シカゴ Itasca, IL Tel: 630-285-0071 Fax: 630-285-0075 ダラス Addison, TX Tel: 972-818-7423 Fax: 972-818-2924 デトロイト Novi, MI Tel: 248-848-4000 ヒューストン TX Tel: 281-894-5983 インディアナポリス Noblesville, IN Tel: 317-773-8323 Fax: 317-773-5453 Tel: 317-536-2380 ロサンゼルス Mission Viejo, CA Tel: 949-462-9523 Fax: 949-462-9608 Tel: 951-273-7800 ローリー NC Tel: 919-844-7510 ニューヨーク NY Tel: 631-435-6000 サンホセ CA Tel: 408-735-9110 Tel: 408-436-4270 カナダ - トロント Tel: 905-695-1980 Fax: 905-695-2078			